

マテリアル先端リサーチインフラ設備供用拠点(ARIM)ご利用をご検討の皆様

2025 年度（令和 7 年 度）ARIM 利用申請についてご案内いたします

マテリアル先端リサーチインフラ（ARIM）事業において、装置利用に伴い創出されるマテリアルデータを利活用すべく、データ提供をお願いしています。

原則、申請承認後のデータ提供意思表示の変更はでき兼ねますのでご了承ください。

今年度より利用料金の上限額の月極及び年極金額を改定しておりますので、ご承知おきください。

また、下記の機器利用料金も改定しております。

- ・レーザーラマン顕微鏡
- ・走査型プローブ顕微鏡
- ・物理特性測定装置（PPMS）
- ・ナノインプリント装置
- ・薄膜X線回折装置
- ・ナノ粒子解析装置（ゼーターサイザー）

本年度よりDMFとエスペイサーの取り扱いが変更になりましたのでご注意ください。

ARIM事業では、「データ構造化システム（RDE）」にデータ登録をしております。

データ登録には、NIMSが提供するデータ基盤（DICE）アカウントが必要になるため、申請前に下記よりDICEアカウントを取得下さい。

事務局でDICEアカウント取得を確認します。

データ非提供の方は、DICEアカウントの取得は必要ございません。

DICEアカウント作成サイト：

<https://diceidm.nims.go.jp/csp/signedup/start>

DICEアカウント作成マニュアル：

<https://www.nims.go.jp/arim/use/lcpdgtk0000000291-att/DICEaccount.pdf>

利用申請書を「ダウンロード後」に入力作成をお願い致します。（**手書不可**）

尚、メールアドレス記入欄には、DICEアカウント取得時に登録したものを
ご記載ください。

申 込 宛 先 : arim-office@sanken.osaka-u.ac.jp

※送付の際は件名に「申請書提出_所属（研究室名等）」を記入の上、送付ください。

また課題名につきましては、SimpRent 内で表記されますのでご承知おきください。

・エクセルのリストには「施設利用者様(申請者様含む)」と「事務担当者様」の情報入力
が必要です。

・研究不正確認日付、保険加入を漏れなくチェックしてください。

・お申し込み後約 2 週間内を目安に、「許可が下りた」旨の連絡をお送りします。

(利用規約やSimpRentの取説などを添付)

・SimpRent への「課題」、「ユーザー」の登録は当事務局で行います。

※ 申請書にて提出している「予算」に関しては当事務局で登録しますが、申請書提出時
の予算以外を使用したい場合は「予算登録」を各々行ってください。

どうぞよろしくお願い申し上げます。

大阪大学 産業科学研究所

マテリアル先端リサーチインフラ設備供用拠点 (ARIM)

〒567-0047 大阪府茨木市美穂ヶ丘 8-1

文部科学省委託事業【マテリアル先端リサーチインフラ】
大阪大学マテリアル先端リサーチインフラ設備供用拠点

令和7年度支援利用申請書

【ARIM加工・デバイスプロセス分野/ARIM物質・材料合成プロセス分野用】

申請日

大阪大学マテリアル先端リサーチインフラ設備供用拠点長 殿

支援利用申請者

氏 名：

カタカナ：

職 名：

所 属：

所 在 地：〒

TEL：

E-mail：

年齢区分： 20歳代 30歳代 40歳代 50歳代以上

指導教官（申請者が学生／院生の場合）

氏 名：

カタカナ：

職 名：

所 属：

E-mail：

下記のとおりマテリアル先端リサーチインフラ設備供用拠点を利用したいので申請します。

記

1. 申請課題名

和文：

Eng：

2. ARIM事業の意思確認

ARIM事業（公開） 自主事業（非公開）

3. ARIM事業の場合、データ提供の意思確認

データ提供： する しない

4. 希望する支援利用形態（申請時は複数選択可）

- （1） 機器利用
- （2） 技術代行
- （3） 技術補助
- （4） 協力研究/共同利用
- （5） 技術相談

5. 利用の期間（年度内）

利用開始日

～ 利用終了日

6. 利用したい装置【ARIM加工・デバイスプロセス分野/ARIM物質・材料合成プロセス分野用】

↓利用したい装置の欄にチェック ※装置稼働状況はWebサイトをご確認ください。

レ 印	装置 番号	ARIM 装置番号	設備（設備群）名	メーカー・機種	CR
	F11	OS-101	高精細集束イオンビーム装置 (NanoFab)	ZEISS “ORION NanoFab”	
	I21	OS-114	RF スパッタ成膜装置（金属成膜用）	サンヨー電子 “SVC-700LRF”	○
	I22	OS-115	RF スパッタ成膜装置（絶縁体成膜用）	サンヨー電子 “SVC-700LRF”	○
	I23	OS-110	リアクティブイオンエッチング装置 (10NR)	サムコ “RIE-10NR-NP”	○
	I24	OS-109	深掘りエッチング装置（400iPB）	サムコ “RIE-400iPB-NP”	○
	I25	OS-103	超高精細電子ビームリソグラフィー装 置（125keV EBL）	エリオニクス “ELS-100T”	○
	N01	OS-102	SEM 付集束イオンビーム装置 (Nvision)	ZEISS “Nvision 40D with NPVE”	●
	N02	OS-111	リアクティブイオンエッチング装置 (10NOU)	サムコ “RIE-10NOU”	●
	N03	OS-113	多元 DC/RF スパッタ装置	キャノンアネルバ “EB1100”	●
	N05	OS-117	EB 蒸着装置	アルバック “UEP-2000 OT-H/C”	●
	N07	OS-126	接触式膜厚測定器	BRUKER “DektakXT-A”	●
	N08	OS-107	マスクアライナー	ミカサ “MA-10”	●
	N09	OS-105	高速大面積電子ビームリソグラフィー 装置（50keV EBL）	エリオニクス “ELS-S50LBC”	●
	N10	OS-104	自動搬送電子ビーム描画装置（150kV BODEN）	エリオニクス “ELS-BODEN- OU4801”	●
	N31	OS-127	レーザーラマン顕微鏡	ナノフォトン “RAMAN-touch VIS-NIR-OUN”	
	N32	OS-125	走査型プローブ顕微鏡	日立ハイテクサイエンス “AFM5000/AFM5300E”	
	N33	OS-128	物理特性測定装置（PPMS）	日本カンタム・デザイン “DynaCool-9”	
	S01	OS-108	ナノインプリント装置	Obducat “Eitre 3”	●
	S32	OS-120	薄膜 X 線回折装置	リガク “Ultima IV”	
	S35	OS-123	ナノ粒子解析装置（ゼーターサイザ ー）	シスメックス “NANO-ZS”	

CR 欄に○もしくは●がある装置はクリーンルーム内に設置されています。入室時にクリーンルーム入室料が別途加算されます。

利用申請書提出後の利用したい装置の追加は可能です。

【※付帯装置の課金について】

以下の装置については利用したい装置としての申請は不要ですが、課金対象装置になります。

また、下記装置のみのご利用はできません。必ず上記の装置ご利用の上、下記の装置をご利用くださいますようお願い致します。

装置番号	設備（設備群）名	メーカー	CR
N71	タングステンコーター	エリオニクス	●
N72	プラズマクリーナー	日本電子	●
N73, I73	スピコーター	ミカサ	●○
N74	UV オゾンクリーナー		●
N75	ワイヤーボンダー		

7. 本申請課題に関連した助成金・競争的資金

本申請課題に関連した助成金や競争的資金を得ている場合、その予算名および課題名（該当なき場合は「なし」と記入）

学内 ※大阪大学は下記予算必須

予算名（プロジェクト名）： _____
 （例：「科研費（基盤 A）」、「（公財）〇〇振興会 スタートアップ研究助成」、「A-STEP〇〇育成事業」）

予算種別： _____

プロジェクトコード： _____

所管コード： _____

学外

課題名（任意）： _____

（利用負担金の実際の支払い財源の問い合わせではありません。助成金や競争的資金の申請課題を実施するあたり、研究・開発計画の一部について当拠点を利用して進める場合にご記入ください。）

8. 事務担当者(研究室内の会計担当者など)

（すべての項目を正確に記入してください）

- ① 氏 名：
 カタカナ：
 職 名：
 所 属 名：
 所 在 地：〒

TEL：
 E-mail：

- ② 氏 名：
 カタカナ：
 職 名：
 所 属 名：
 所 在 地：〒

TEL：
 E-mail：

9. 確認事項

下記確認事項について、内容をご確認いただきチェックをお願いします。

大阪大学マテリアル先端リサーチインフラ設備供用拠点利用規程を確認済み

DICEアカウントの取得、並びにデータ提供に関して確認済み（データ提供の場合）

本申請の提出にあたり、所属上長・指導教官等契約権限を委任された者の承諾取得済み

秘密保持契約等別途合意文書が必要な場合は、事前承認が必要であることを確認済み

実験終了後に利用報告書を提出